

当前位置: [科技部门户](#) > [新闻中心](#) > [科技动态](#) > [国内外科技动态](#)

【字体: 大 中 小】

韩国发明三进制超节能半导体元件和电路技术

日期: 2017年12月14日 来源: 科技部

韩国研究财团发布消息称,成均馆大学研究组发明了可以体现三进制新概念超节能半导体元件和电路技术。该技术突破了目前二进制数字信号传送的计算机处理技术界限。该技术与目前不同材料垂直结合方式、电流特性和电路方式完全不同,是一项独创的研究成果,为半导体元件与电路的研究开辟了新的方向,具有重要意义。

研究组通过表面无缺陷的黑磷和二硫化铼的垂直结合,开发出具有电压增大、电流就减少特性的新型半导体元件。该技术设计独特,为研发超节电元件和超节电三进位制的转换电路奠定了基础。

该项成果获得韩国2017年“科学技术人奖”。

[打印本页](#)

[关闭窗口](#)



版权所有: 中华人民共和国科学技术部

地址: 北京市复兴路乙15号 | 邮编: 100862 | [地理位置图](#) | ICP备案号: 京ICP备05022684